

규 격 / 사 양 서

1. 개요	품명	세정장비		
	수량	1	제조사	
2. 용도 및 특징	본 세정장비(wet station)는 웨이퍼 표면의 불순물, 미세 오염물질, 자연 산화막 등을 제거하여 청정도를 확보하는 웨이퍼 세척 장비임. 6인치 및 4인치 실리콘 등의 웨이퍼 세정에 사용하며, SPM cleaning, SC-1 cleaning, HF를 이용한 자연 산화막 제거 및 D.I water cleaning을 통해 습식 세정 공정을 수행함. 웨이퍼 공정 투입 초기 세척뿐 아니라 개별 공정 사이의 클리닝에도 상시 사용되는 반도체 공정의 필수 기초 장비로서, 웨이퍼의 청정도를 유지하고 다음 공정의 성공률을 높여 소자의 신뢰성과 재연성을 확보하는 데 사용됨.			
3. 기기구성 (세부내용, 수량 등)	- SPM cleaning bath(Quartz 재질) 1개 - SC-1 cleaning bath(Megasonic 적용) 1개 - DHF bath(PTFE 재질) 1개 - QDR bath(clear PVC 재질) 3개 - Control Panel 1개			
4. 규격 및 사양	※ 본 규격은 최소 요구 성능을 정한 것이며, 동등 이상의 성능 및 품질을 갖춘 제품의 납품을 허용함. Bath 1: SPM cleaning - 수치: 부피 7 L - 설명: Sulfuric-peroxide mixture로 웨이퍼 표면의 contaminant 제거 Bath 2: SC-1 cleaning - 수치: 부피 7 L - 설명: Dry etch 후 구조물의 표면 및 측면 바닥 영역에 축적된 탄소 계열 residual을 효과적으로 제거 Bath 3: DHF (Diluted HF) bath - 수치: 부피 7 L - 설명: Native oxide 제거, ohmic contact 형성 Bath 4/5/6: QDR Rinse bath 3개 - 수치: 각 부피 7 L - 설명: 상기 각 cleaning 후 초순수 최종 세척 (각 bath 6회 cyclic cleaning) Control panel - 전자식 터치 패널 방식 - 설명: 시간, 온도, 사이클 수, 폐액 처리 제어			
5. 설치, 교육 및 사후관리	숙련된 엔지니어의 장비 설치 및 시험가동 진행			
6. 품질보증 기간 (Warranty)	1년			
7. 납기일자	계약체결일로부터 3개월 이내			

8. 계약업체 제출서류	
9. 참가자격	
10. 참가자격 제출서류	
11. 기타사항	지능형반도체학과/ 조성재 교수님/ felixcho@ewha.ac.kr 담당자 고은이 neosilver0@ewha.ac.kr